

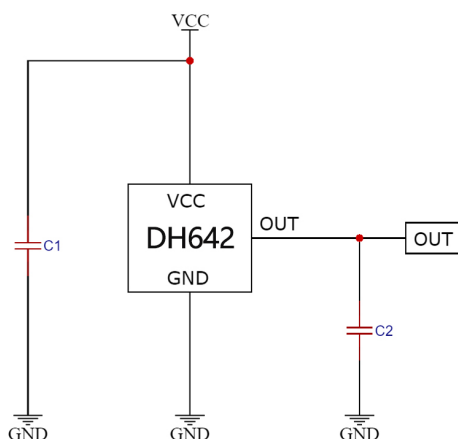
1 产品特点

- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 宽工作电压范围：2.8V~6.0V
- 低功耗 3.3mA@5.0V V_{DD}
- 低噪声输出
- $V_{CC}/2$ 静态输出，可检测N极和S极磁场
- 多灵敏度可选
 - A: 5.0mV/Gs, ± 480 Gs 范围
 - B: 9.0mV/Gs, ± 266 Gs 范围
- 高品质封装：SOT-23-3L TO-92S
- 工作温度范围：-40℃~125℃
- 卓越的ESD性能：HBM 4KV
- 符合RoHS & REACH 标准

2 典型应用

- 电流传感器
- 电机控制
- 位置检测
- 接近开关
- 高度找平、倾斜和重量测量
- 角度编码

3 应用电路原理图

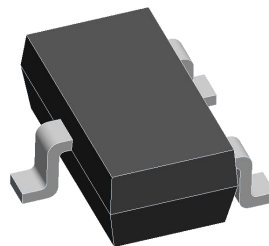


注：C_{IN}: 1nF/10V
C_{Out}: 10nF/10V

4 概述

DH642是一款线性霍尔效应传感器，可按比例响应磁通量密度。DH642内部电路包含霍尔传感器、线性放大器和CMOS输出级电路。具有高速、低噪声输出特性，在-40℃至125℃的宽温度范围内实现线性性能。可用于消费类工业类各种磁场检测。

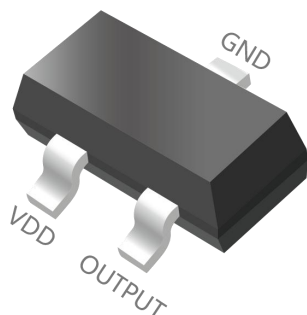
DH642具有宽工作电压范围，当不存在磁场时，模拟输出 $1/2 V_{CC}$ 。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化，两个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。DH642可检测垂直于封装顶部的磁通量。由于采用标准的SOT-23-3L和TO-92S封装，DH642可提供不同的检测方向。



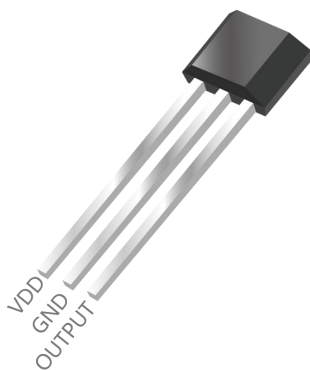
SOT-23-3L



TO-92S

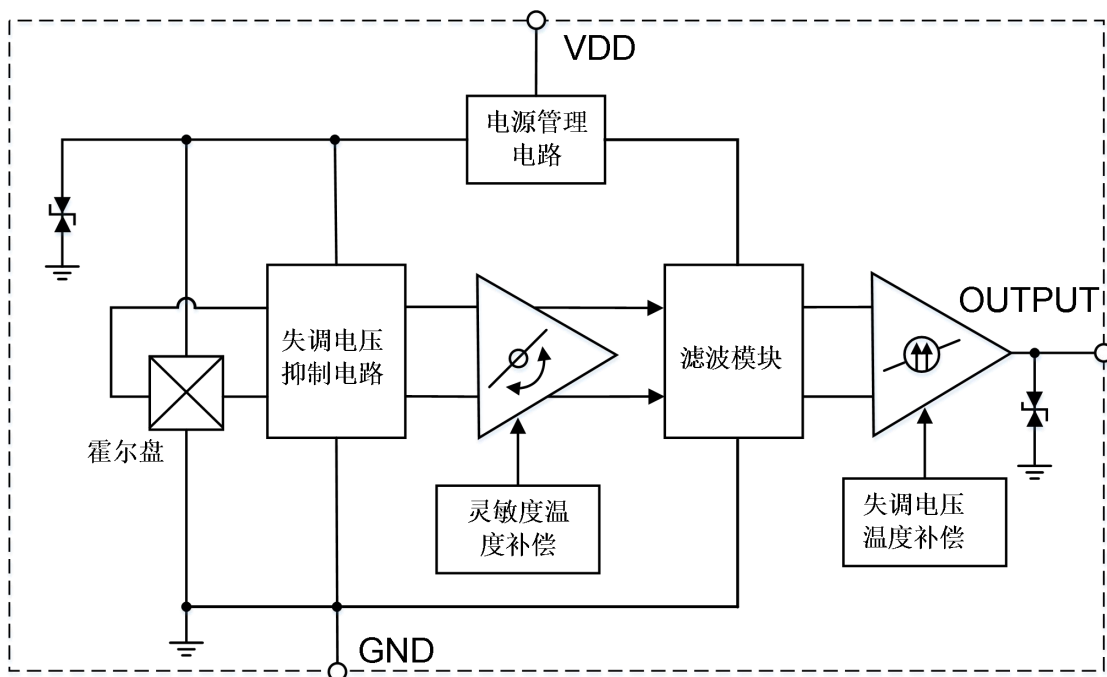
5 引脚定义和标记信息**SOT-23-3L****引脚结构 (俯视图)**

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

TO-92S**引脚结构 (俯视图)**

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	3	输出端

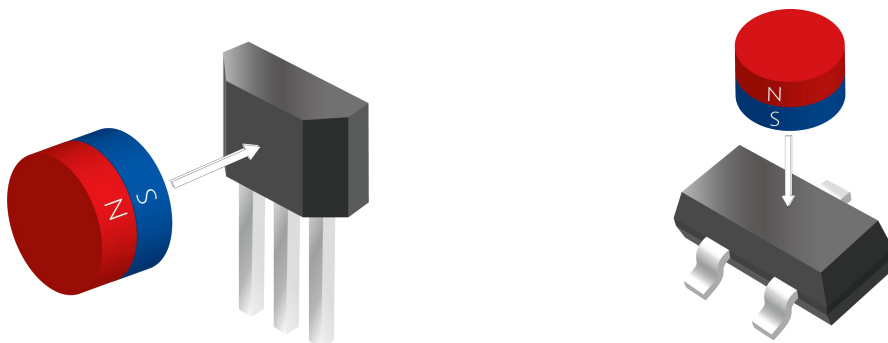
6 功能框图

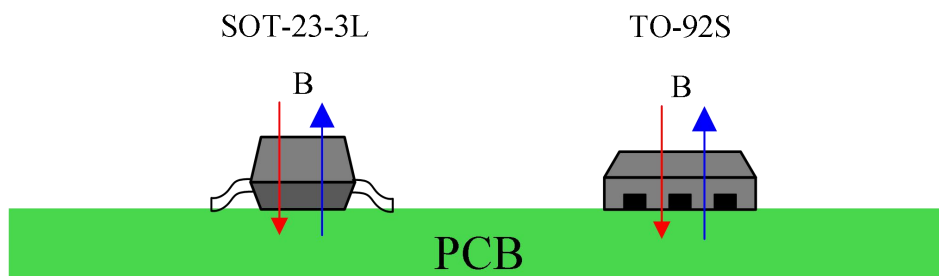


7 输出特性 ($T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$, $V_{DD} = 2.8\text{V} \sim 6.0\text{V}$)

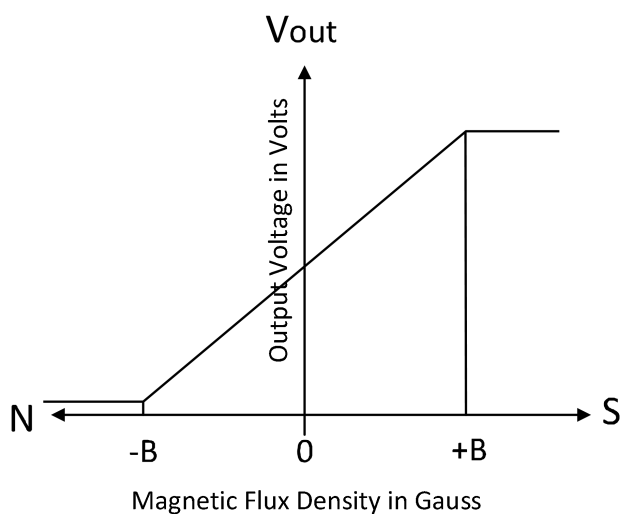
项目	工作条件	输出 (TO-92S)	输出 (SOT-23-3L)
South pole	$B > 0$ Gauss	$> V_{NULL}$	$> V_{NULL}$
North pole	$B < 0$ Gauss	$< V_{NULL}$	$< V_{NULL}$

如下图，DH642可检测垂直于封装顶部的磁通量。当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度 B 为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度 B 为负。





输出特性



8 产品型号构成

DH642 XX-XXX

封装简称: ST3: SOT-23-3L

TO3: TO-92S

灵敏度: A:5.0mV/Gs B:9.0mV/Gs

9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明		数值	单位
V _{DD}	供电电压		8	V
V _{DD_REV}	反向电源电压		-0.5	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流		20	mA
V _{OUTPUT}	输出电压		8	V
T _A	工作温度范围		-40~+125	°C
T _{STG}	存储温度范围		-65~+150	°C
T _J	结点最高耐温		+150	°C
P _D	封装功耗	SOT-23-3L/TO-92S	230/606	mW
ESD HBM	人体模型ESD能力		4000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。

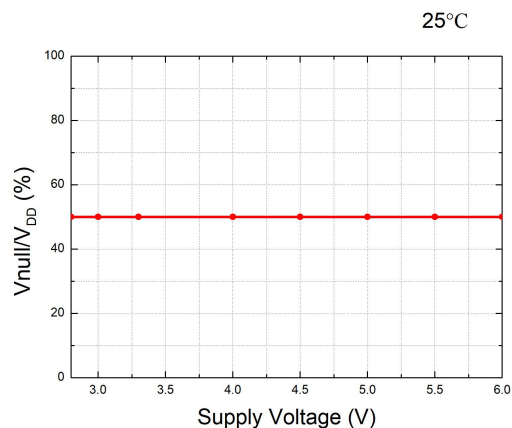
具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器

10 电参数 (@TA=+25℃, V_{DD}=5.0V 除特别说明外)

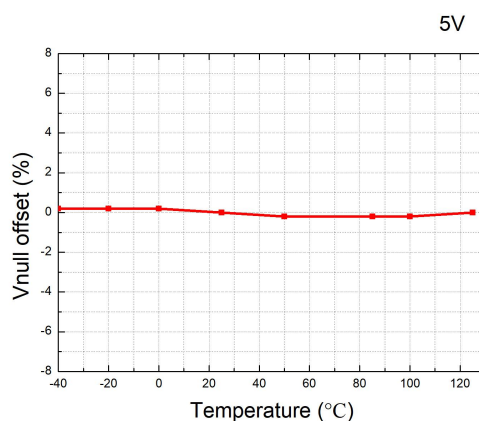
DH642系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态	2.8	—	6.0	V
I _{DD}	功耗电流	工作状态, B=0 Gs	—	3.3	5.0	mA
I _O	输出电流	V _{DD} >3V	1.0	1.5	—	mA
V _{NULL}	0 磁场输出电压	B=0 Gs	2.325	2.5	2.675	V
V _{OH}	输出高电平	B> Max Magnetic Gauss	—	4.9	4.99	V
V _{OL}	输出低电平	B> Min Magnetic Gauss	0.01	0.1	—	V
V _{OS}	输出电压摆幅范围	工作状态	—	4.8	—	V
V _{ON}	输出噪声	Ta=25℃, C _{Out} =10nF	A	—	100	mV
			B	—	110	mV
T _P	上电时间	工作状态	—	—	150	uS
T _{SW}	输出转换时间	工作状态	—	—	150	uS
F _{SW}	输出转换频率	工作状态	3	—	—	kHz
Magnetic Range	磁场检测范围	A	-480	—	480	Gs
		B	-266	—	266	Gs
Sensitivity	灵敏度	A	4.6	5.0	5.4	mV/Gs
		B	8.28	9.0	9.72	mV/Gs
R _{VON}	0 磁场输出电压误差	实际工作电压/5V 工作电压	—	±1.5	—	%
R _{SEN}	灵敏度误差	实际工作电压/5V 工作电压	—	±1.5	—	%
LIN	线性度	全输出电压范围	—	±1.5	—	%
TC _{Sens}	灵敏度温度系数	Sens@125℃/Sens@25℃	—	±0.1	—	%/℃
δ V _{ON}	0 磁场输出电压随温度变化幅度	V _{ON} @125℃-V _{ON} @25℃	—	20	—	mV

11 性能曲线图

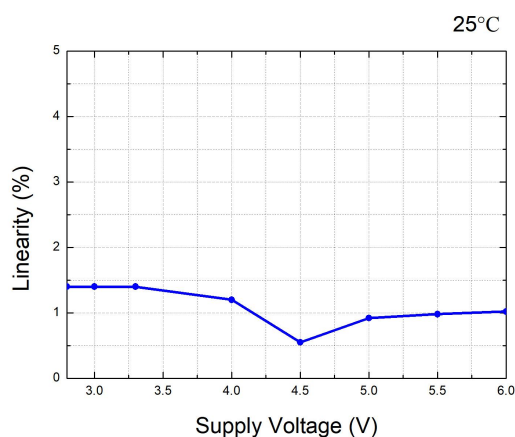
DH642-A/B



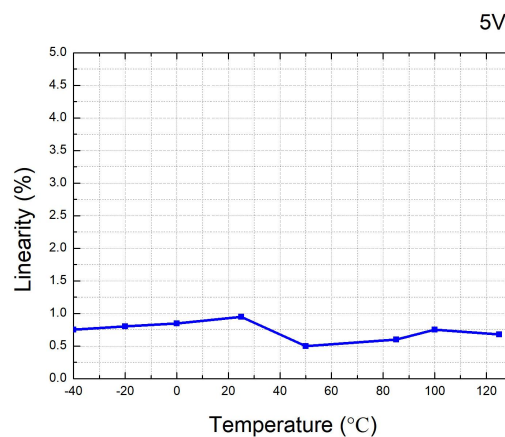
Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Ratio of V_{NULL} to V_{DD}



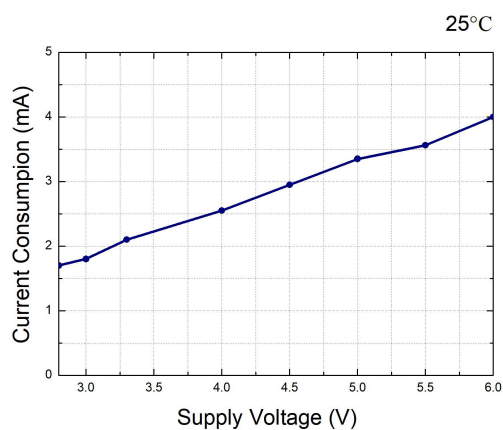
Typical Temperature (T_A) VS V_{NULL} Offset



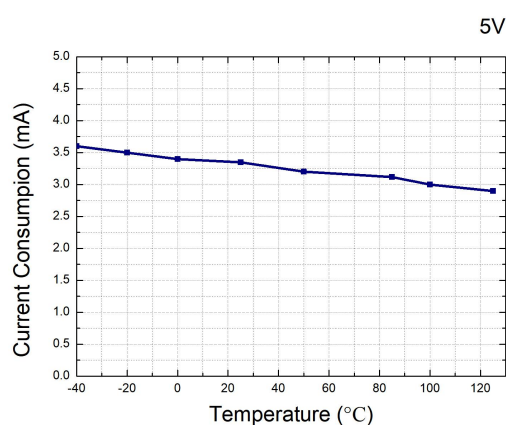
Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Linearity



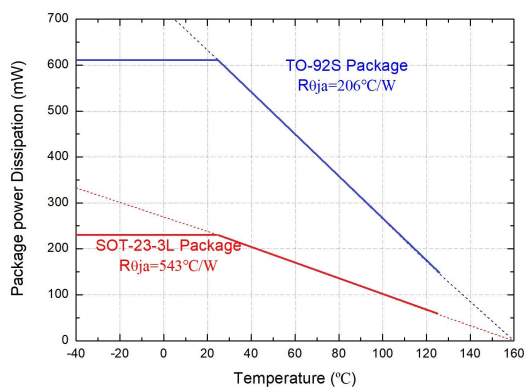
Typical Temperature (T_A) VS Linearity



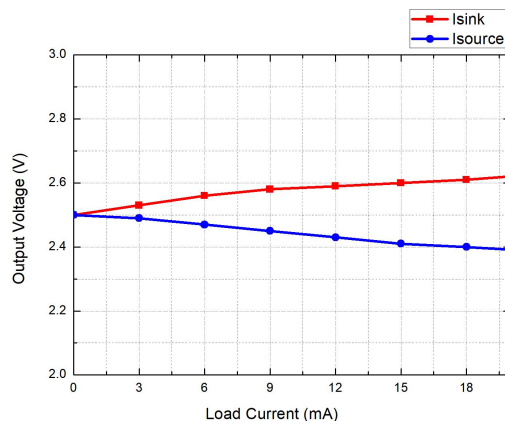
Typical Supply Voltage (V_{DD}) VS Supply Current (I_{DD})



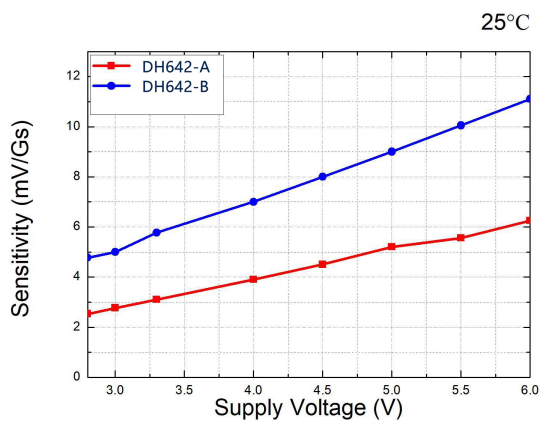
Typical Temperature (T_A) VS Supply Current (I_{DD})



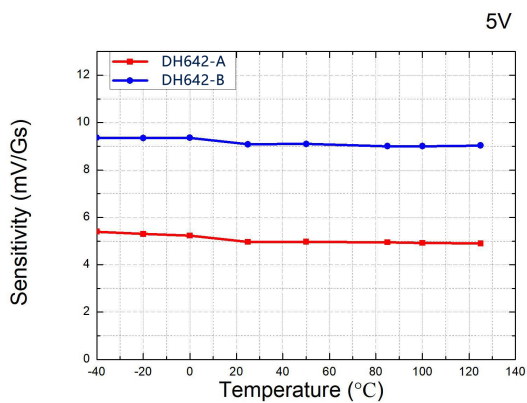
Power Dissipation VS Temperature(TA)



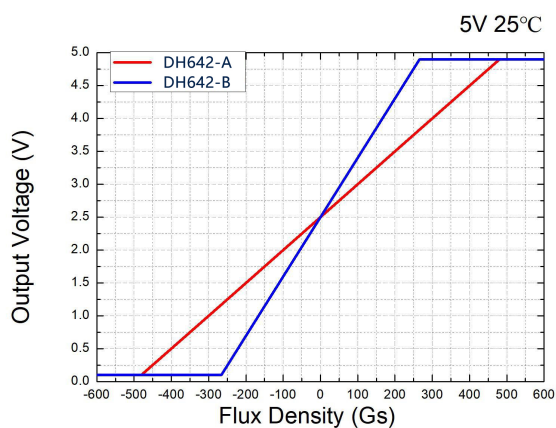
Load Current VS Output Voltage



Typical Supply Voltage(V_{DD}) VS Sensitivity



Typical Temperature (TA) VS Sensitivity



Typical Flux Density VS Output Voltage

12 功能参数描述

(1) V_{DD} 引脚

该引脚为芯片供电引脚。供电电压必须大于最小要求的工作电压 2.8V。

(2) GND 引脚

该引脚为芯片接地引脚，并且需要保证与供电电源的地是强连接。

(3) Output 引脚

DH642 为推挽式输出结构，无需上拉电阻。当无外加磁场时，输出电压为 V_{DD}/2。当向芯片施加 S 极磁场时，输出电压会大于 V_{DD}/2。当向芯片施加 N 极磁场时，输出电压会小于 V_{DD}/2。输出电压更新都会发生在 T_{sw} 之后。

(4) 上电时间 (Power on Time)

当向芯片施加电压时，芯片需要一定的建立时间来响应外加磁场。

(5) 零输出电压 (Null Voltage output)

当外加磁场为 0 时，输出电压为电源电压 V_{DD} 电压的一半。

(6) 灵敏度 (Sensitivity)

输出电压的变化量正比于磁场强度的变化量，这种正相关性如下式：

$$Sens = \frac{V_{OUT(B+)} - V_{OUT(B-)}}{(B+) - (B-)}$$

(7) 线性度 (Linearity)

芯片对于线性磁场可以提供线性输出。考虑两个磁场点，B₁ 和 B₂，理想情况下，对于给定的供电电压和温度，芯片的灵敏度在两个磁场点上是相同的。对于正向磁场和负向磁场分别给出了线性度计算如下式：

$$Lin_{B+} = (1 - \frac{Sens_{(B2+)}}{Sens_{(B1+)}}) \times 100\%$$

$$Lin_{B-} = (1 - \frac{Sens_{(B2-)}}{Sens_{(B1-)}}) \times 100\%$$

(8) 比例输出误差 (Ratiometry Error)

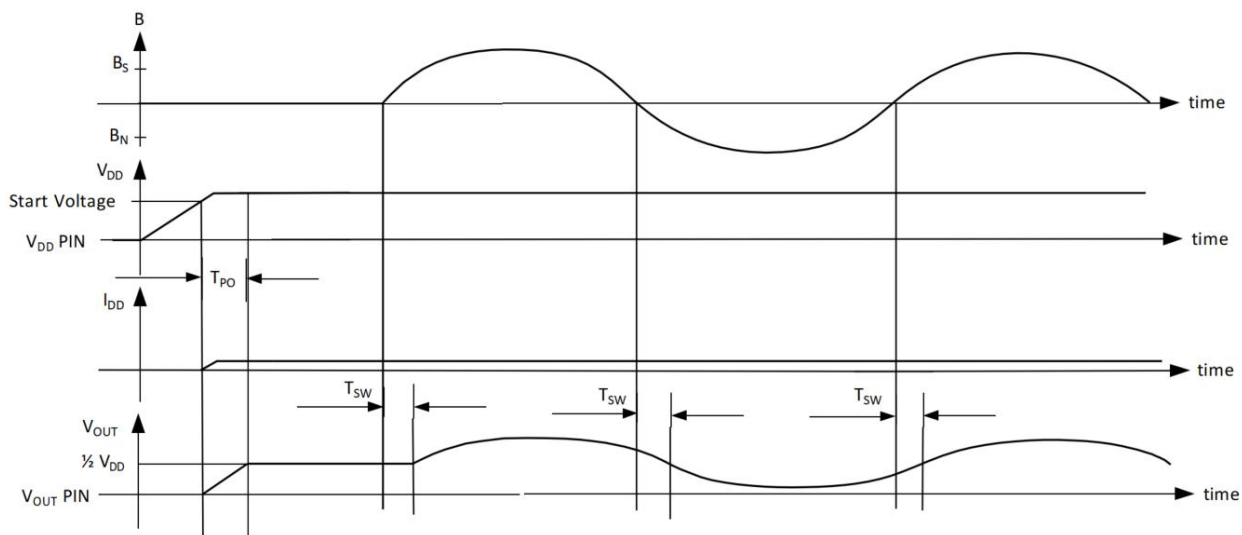
芯片提供比例输出模式。这意味着 0 电压输出 V_{null}，灵敏度 Sens，正比于供电电压 V_{DD}。比例值相对于 5V 而言，如下式所示：

$$R_{Von} = (1 - \frac{V_{null_{V_{DD}}} / V_{null_{5V}}}{V_{DD} / 5V}) \times 100\%$$

$$R_{Sens} = (1 - \frac{Sens_{V_{DD}} / Sens_{5V}}{V_{DD} / 5V}) \times 100\%$$

时序图

Power on timing



- **Power-On time (T_{PO}):**

外接电源给芯片供电开始到芯片正常工作，这之间的时间。

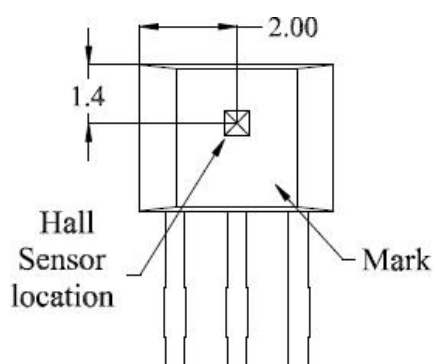
- **Output switch time, (T_{SW}):**

从磁场变化开始到芯片输出响应相应的变化，这之间的时间。

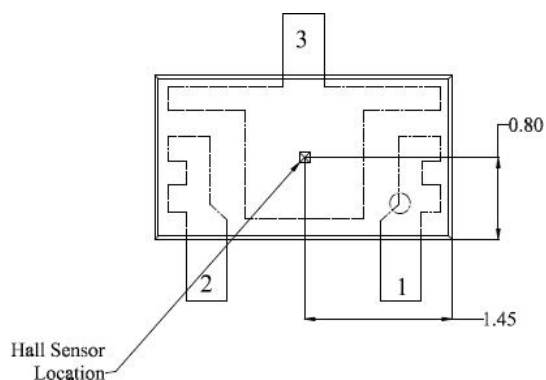
13 订货信息

型号	封装形式	引脚数	灵敏度	温度
DH642-A-ST3	SOT-23-3L	3	5.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH642-B-ST3	SOT-23-3L	3	9.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH642-A-TO3	TO-92S	3	5.0mV/Gs	-40℃~125℃
DH642-B-TO3	TO-92S	3	9.0mV/Gs	-40℃~125℃

14 Hall盘位置



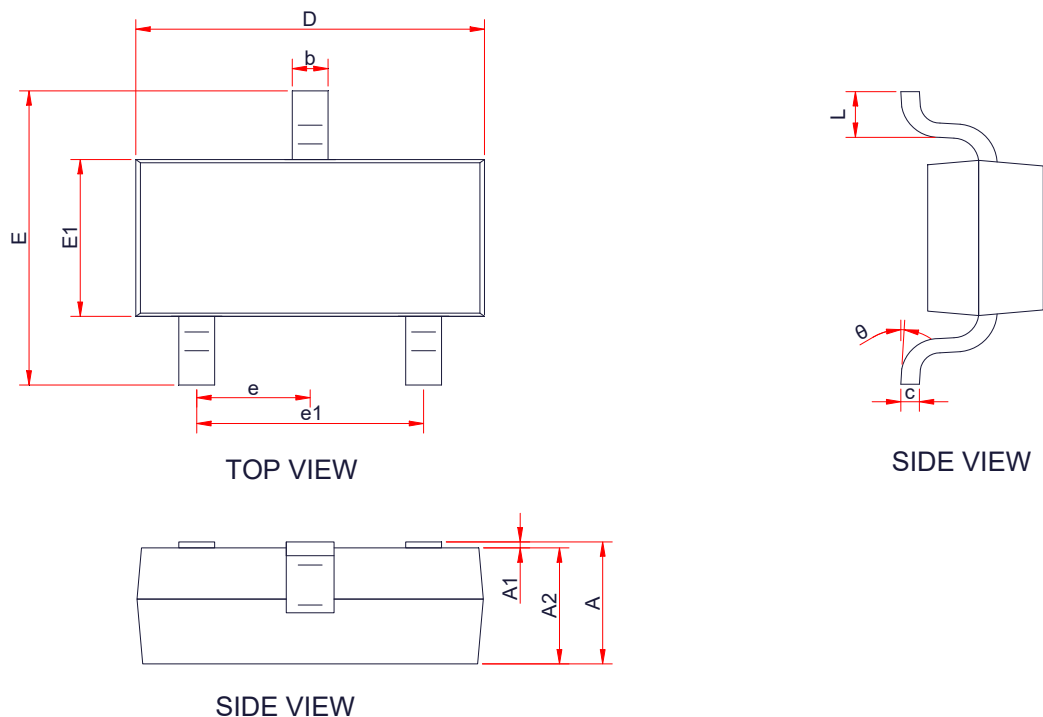
Top View



Bottom View

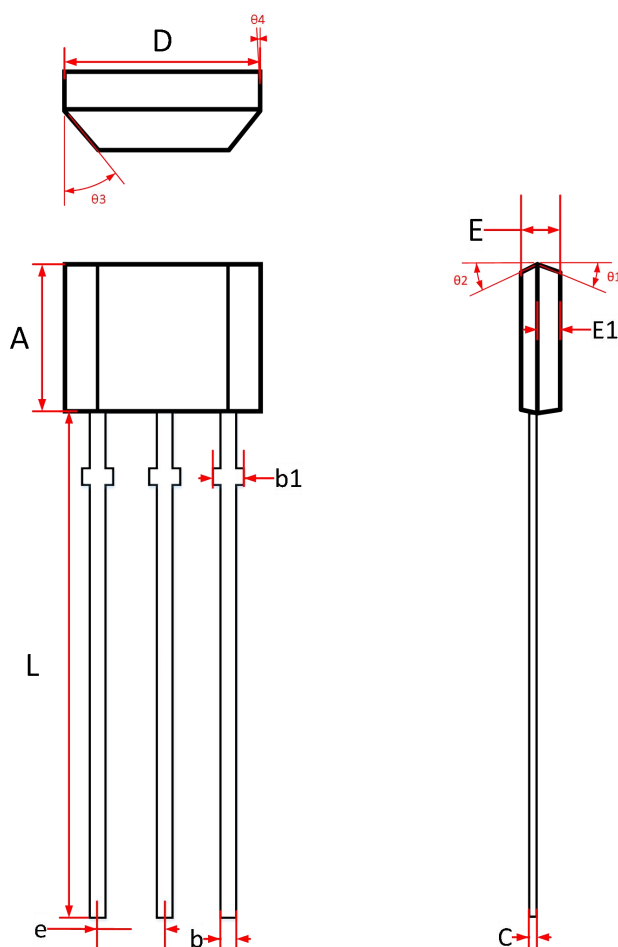
封装外形尺寸图

SOT-23-3L



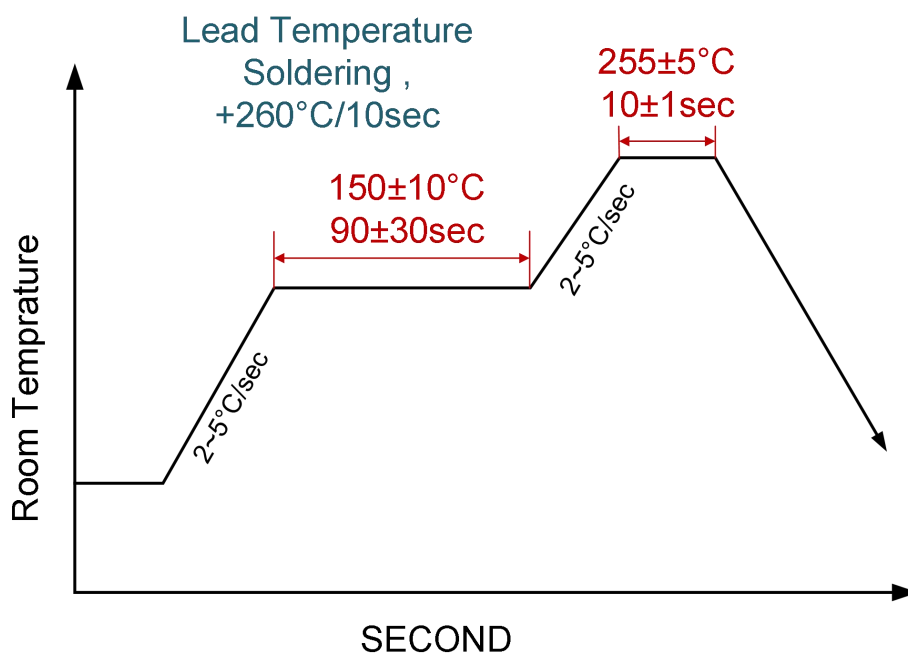
Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.25
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °

TO-92S

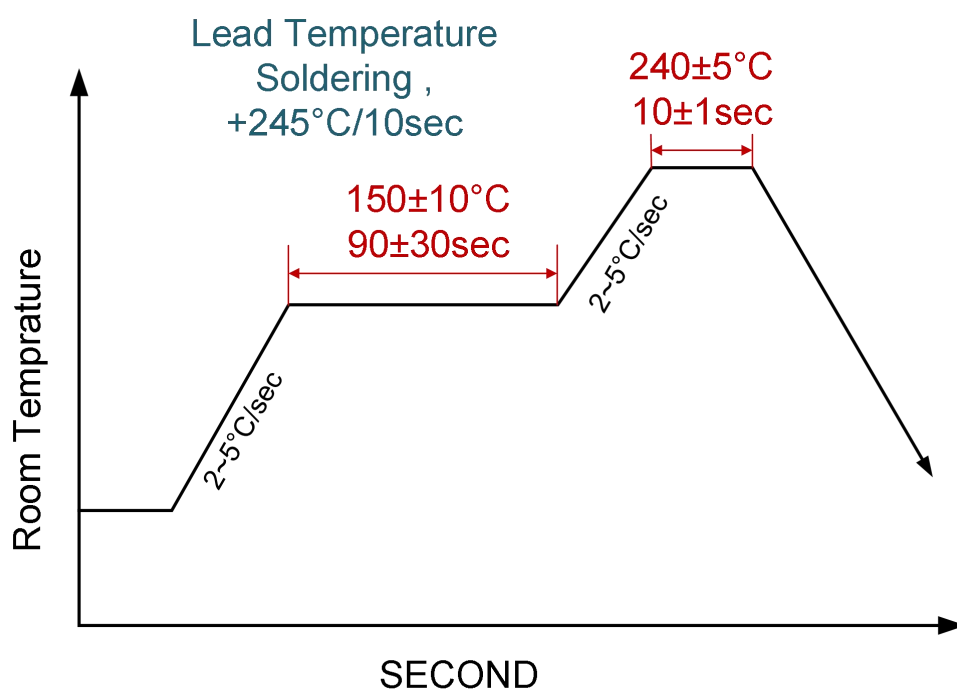


Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
$\theta 1$		6°	
$\theta 2$		3°	
$\theta 3$		45°	
$\theta 4$		3°	

IR Reflow curve



SOT-23-3L Soldering Condition



TO-92S Soldering Condition